19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—192027

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 7131-5F 砂公開 昭和57年(1982)11月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈感光性樹脂窓の形成方法

②特 願 昭56-77200

愛出 願 昭56(1981)5月20日

⑩発 明 者 須川俊夫

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑩発 明 者 小沼毅

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑫発 明 者 永村和代

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1夕

明 細 前

1、発明の名称

感光性樹脂窓の形成方法

2、特許請求の範囲

- (1) 基板上に少なくとも2層の感光性樹脂膜より なる多層膜を形成し、前記感光性樹脂膜のエッチ ング条件を異ならせることにより前記感光性樹脂 膜のうち前記基板に接する膜の開口部が他の前配 感光性樹脂膜の開口部を含せることを特徴とする感光性 樹脂窓の形成方法。
- (2) エッチング条件を各感光性樹脂膜の感度によって異ならせることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の感光性樹脂窓の形成方法。
- (3) エッチング条件を各感光性樹脂膜への照射光のちがいによって異ならせることを特徴とする特許求の範囲第1項記載の感光性樹脂窓の形成方法。
- (4) 多層膜が第1の感光性樹脂膜と第2の感光性 樹脂膜とよりなり、前記第1の感光性樹脂が電子

線感光性樹脂であり、前記第2の感光性樹脂膜が 光感光性樹脂であり、前記第1の感光性樹脂で電子線を照射し、前記第2の感光性樹脂で光を照射 することによって後工程におけるエッチング条件 を異ならせることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の感光性樹脂窓の形成方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は感光性樹脂窓の形成方法に関するものであり、特に二層以上の感光性樹脂を用いることによってわずかに大きさの異る窓を形成する感光 性樹脂窓の形成方法に関するものである。

従来、例えば電界効果トランジスタ等の電子部品の製造には半導体基板上に感光性樹脂を被着し、電光、現像の後エッチングによって所望パターンを形成するフォトエッチング法が用いられている。一方微細なパターンでしかもエッチングが困難な例えば金等の金属においてはリフトオフ法が用いられている。

すなわち第1図A)に示す如く例えばSi 基板1 表面上に感光性樹脂を強布し露光, 現像によって 所望領域選択的に感光性樹脂2を残存せしめる。 しかる後金属として例えば金3を蒸着する。そして感光性樹脂2を除去することによって感光性樹脂2上の金3も同時に除去され、第1図(B)に示す如く感光性樹脂2が選択的に被着されていなかった領域にのみ金3が残存し所望パターンに金3が被着形成されるものである。

このリフトオフ法は通常被着形成すべき金の厚さに比べて感光性樹脂が充分厚く、しかも感光性樹脂側壁の傾斜が急しゅんである場合のみ可能である。これらの条件が満足されない場合、金とSi 基板の間の感光性樹脂が除去出来ず所望パターンの金が得られなくなってしまう。

また感光性樹脂と基板との間にSiO₂膜等の絶線膜を被着し該SiO₂膜を感光性樹脂をマスクとしてエッチングする方法も従来用いられている。この方法はエッチング時のサイドエッチによって感光性樹脂のひさしを形成してリフトオフを容易にするものである。この場合SiO₂膜を厚くすればサイドエッチ量が大きくなりひさし領域の感光

性樹脂がだれることにより逆にリフトオフを困難とする。SiO2膜が薄い場合はひさしの効果は得られなくなる。通常用いられているSiO2膜厚か3000Å程度でも金属は~3000Å程度すなわちSiO2膜厚と同等の厚さ厚くしてリフトオフを可能とするものでしかなかった。

本発明は前配従来の欠点を除去するものであり、 二層以上の感光性樹脂に対して感光領域を実質的 感光量,照射光の波長を変えるかもしくは感光特 性の異る感光性樹脂を用いることによって各層の 感光性樹脂の窓の大きさを微妙に異ならせること によってリフトオフ等に適した窓を形成するもの である。

以下本発明を図面を参照しながら実施例を用いて説明する。

(実施例1)

3. 基板表面上に同波長の光に対して感度の異る感光性樹脂を用いる。例えばポジ形感光性樹脂であるAZ-1370(商品名)は波長が300mmの選案外光に対して感度が高いが、一方同じ

5 A-3

ポジ形感光性樹脂であるAZ-2415(商品名) は前配波長の光に対してより充分低感度である。

第2四角に示す如くSi 基板 4 表面上に第1層 目の感光性樹脂として高感度のA2~1370(6)を 回転速度 4000 r. p. m で 回転塗布した後、さら に第2層目の感光性樹脂として低感度のA2-2145(6) を回転速度 4000 r. p. m で回転塗布し てそれぞれ被着形成した後、選択露光のためのマ スクを通して300nm の遠紫外光を照射する。 とのとき第1層目の高感度の感光性樹脂A2-13706)はマスク端部の回折、基板からの反射等 の少量の光でも感光するためマスクよりも拡大さ れた領域が感光されてしまうが第2層目の低感度 のA2-2415(6)は少量の光では感光されないた めマスクと同等の所望領域のみが感光される。し かる後現像処理を行りことによって前記感光され た領域の感光性樹脂すなわちA2-1370, A2 - 2415がそれぞれ選択除去される。このとき第 2図(B)に示す如く第1層目のAZ-1370(5)の方 が第2層目のAΖー2415(6)より大きい窓が前述

6 /-

した感光領域によって形成される。このことは第 2四〇に示す如く金属膜として例えば金でを蒸着 した場合、窓周辺での金での切れを良好なものと しリフトオフを容易に行うことを可能とし、さら に金でを従来より大幅に厚くすることを可能とす るものである。

(実施例2)

第3四(A)に示す如くSi 基板Bの表面上に第1の感光性樹脂としてポジ形感光性樹脂であるA Z - 1370(B)を回転速度 4000 r. p. m で回転塗布した後、選択露光用のマスクを通して300 nm の速紫外光を照射する。通常A Z - 1370は回転速度 4000 r. p. m で~1.2 μ m の厚さが得られ、露光エネルギーが50 mj/cmlで最適であるが本発明の場合過露光とし、例えば70 mj/cml光照射を行う。これにより選択露光のマスクの光が透過する所定領域10より拡大して感光領域11を形成する。次に第2の感光性樹脂として再度A Z - 1370(11)を4000 r. p. m で回転塗布した後、動配選択露光マスクを用いて最適露光量50 mj/

cmの光照射を行う。このとき第2の感光性樹脂は一般適露光であるため選択露光マスクの所定領域10と同等領域の感光領域が形成される。しかる後現像処理を行うことによって第3図(B)に示す如く第2の感光性樹脂であるAZ-1370(12)によってひさしが形成される。

すなわち本実施例2は第1と第2層目の感光性 樹脂は同じ感光特性を持ったあるいは同一の感光 性樹脂を用いて露光量を変えることによって感光 量を各々変え、大きさのわずかに異る窓を形成す るものであり、実施例1と同様リフトオフを容易 にするものである。しかる後実施例1と同様金属 蒸着,感光性樹脂の除去によるリフトオフを行う。 (実施例3)

実施例2に於ては第1の感光性樹脂と第2の感光性樹脂に対して光の照射エネルギーすなわち照射量を変えたが第1の感光性樹脂であるA2ー1370は400mmの紫外光に於ても感度を有している。そこで第1の感光性樹脂のA2-1370に~400mmの紫外光を光マスクを用いて選択

9 (-1 5 を 4000 r. p. m で回転塗布する。しかる後

所望領域 2×10⁻⁴C/cd の電子線を照射し感光さらに被400nmの光によって前記所望領域露光すべき光マスクを用いて光照射した後、PMMA 1 5 および A Z - 1370(14)を順次現像を行う。とこで電子線露光によれば所望寸法に忠実で拡がりの無い開口を得ることが可能であるが通常の400nmの被長程度の紫外光によれば前述した光の回折、基板からの反射によって光であるが通した光の回折、基板からの反射によって光ではからの所望光透過領域より拡大されて窓が形成されるため、第4図(B)に示す如くA Z - 1370(14)による窓16はPMMA 15による窓17より大きくひさしが形成されりフトオフ法に適した窓が得られるものである。

以上説明した如く本発明は少なくとも二層以上の感光性樹脂に対して第1層目と第2層目との感光領域を実質的に変えることによって第1層目と第2層目に於て現像処理後の開口を第1層目より第2層目の方が大きくするものである。これは第1層目と第2層目との感光性樹脂に対する照射光

(実施例4)

第4図(A)に示す如くSi 基板13表面上に第1の感光性樹脂としてAZ-1370(14)を4000 r. p. mで回転塗布した後、さらに電子線に対して感度を有する感光性樹脂例えば PMMA(商品名)

104-

のエネルギーや波長を変えるかあるいはそれぞれ 感光特性の異る感光性樹脂を用いることによって 成し得るものである。本発明によればエッチング 困難な金属をさらに厚く被着しても容易にリフト オフを行うことを可能とするものである。

すなわち、金属を通常のリフトオフ法により感光 性樹脂の厚さと同等 (~1.2 μm)の厚さ追加し て全体の膜厚を大きくしてもリフトオフを可能と するものである。

たお本発明の実施例では基板をSiとして、また感光性樹脂をA2系によって説明したがこれらは特に限定するものではなく基板としてSi以外の半導体はもちろん金属、ポリイミド系の樹脂等にも応用出来るものである。また感光性樹脂は他にオガタイプ感光性樹脂やA2系以外のポジタイプ感光性樹脂をもってしても実現可能であることは言うまでもない。さらに本発明に於て照射光に紫外線の他にX線等の電磁波を用いても良い。

4、図面の簡単な説明

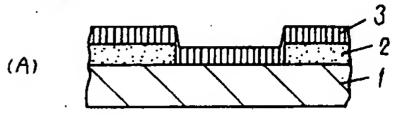
第1図(A)、(B)は従来のリフトオフ法を脱明する

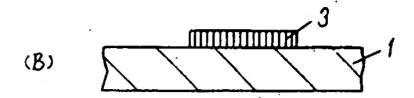
ための工程断面図、第2図(A), (B), (C)は本発明の一実施例における感光性樹脂窓の形成方法を説明するための工程断面図、第3図(A), (B)は本発明の他の実施例における感光性樹脂窓の形成方法を説明するための工程断面図、第4図(A), (B)は本発明のさらに他の実施例における感光性樹脂窓の形成方法を説明するための工程断面図である。

4,8,13 ····· Si 基板、7 ····· 金属、5,9,14 ····· 第1層目の感光性樹脂、6,12,15 ····· 第2層目の感光性樹脂、10 ···· 選択露光マスクの光透過領域、11 ···· ·· 感光領域。

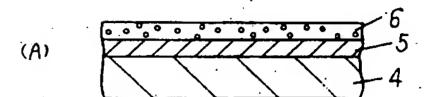
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

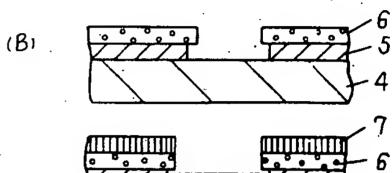
第 1 图

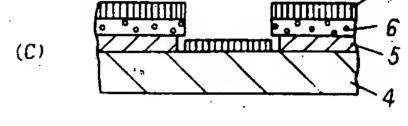




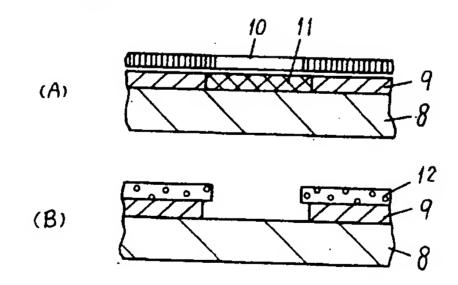
第 2 図







第 3 図



第4图

